





Unormowana impedancja wejściowa we wrotach k

$$z_{wek} = \frac{Z_{wek}}{Z_{0k}} = \frac{a_k + b_k}{a_k - b_k}$$

Dla wielowrotnika liniowego napięcie (prąd) fali wybiegającej z wrót k jest superpozycją fal dobiegających do pozostałych wrót:

 $b_{1} = S_{11}a_{1} + S_{12}a_{2} + \dots + S_{1k}a_{k} + \dots + S_{1n}a_{n} \\ b_{2} = S_{21}a_{1} + S_{22}a_{2} + \dots + S_{2k}a_{k} + \dots + S_{2n}a_{n} \\ \vdots \\ b_{k} = S_{k1}a_{1} + S_{k2}a_{2} + \dots + S_{kk}a_{k} + \dots + S_{kn}a_{n} \\ b_{n} = S_{n1}a_{1} + S_{n2}a_{2} + \dots + S_{nk}a_{k} + \dots + S_{nn}a_{n}$  lub krócej [b] = [S][a]S jest tzw. Macierzą rozproszenia

W przypadku ogólnym macierz rozproszenia S zawiera  $l_w = n^2$  niezależnych wyrazów zespolonych.



Szczególne przypadki					
Wielowrotniki odwracalne $S_{ij} =$	$S_{ji}$ $l_w = \frac{n}{2}$	$\frac{1}{2}(n+1)$			
Wielowrotniki symetryczne		$S_{11} = S_{22}$	$= \ldots = S_{nn}$		
a) pełnosymet	ryczne	$S_{ij} = const$			
		<i>i</i> ≠ <i>j</i>			
b) niepełi	nosymetryc	czne	$S_{ik} = S_{jk}$ $S_{ki} = S_{kj}$ $S_{ii} = S_{jj}$ $k \neq i  k \neq j$		
Wielowrotniki bezstratne $\sum_{k=1}^{n} rac{\left(U_{k}^{+} ight)^{2}}{Z_{ok}}$	$=\sum_{k=1}^{n}\frac{\left(U_{k}^{-}\right)^{2}}{Z_{ok}}$				
(równość sum mocy na wejściowych	i wyjściow	ych)			













straty odbiciowe (ang. return loss)

$$RL = -10\log\frac{P_{R}}{P_{SA}} = -10\log\left(\frac{WFS-1}{WFS+1}\right)^{2} = -10\log|\Gamma|^{2} \ [dB]$$

 $P_R$  – moc odbita od wejścia filtru

przesunięcie fazy (ang. phase shift)

$$\Phi_T = \arg\{S_{21}\}$$

opóźnienie grupowe (ang. group delay)

$$\tau_D = \frac{d\Phi_T}{d\omega} = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi_T}{df}$$







 $g_{1} = \frac{2a_{1}}{\gamma} \qquad \gamma = \sinh \frac{\beta}{2n} \qquad \beta = \ln\left(ctgh\frac{A_{n}}{17,37}\right)$   $g_{k} = \frac{4a_{k-1}a_{k}}{b_{k-1}g_{k-1}} \qquad k = 2,3...n \qquad a_{k} = \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2\pi}\right], \qquad k = 1,2...n$   $b_{k} = \gamma^{2} + \sin^{2}\frac{k\pi}{n}, \quad k = 1,2...n$   $g_{n+1} = tgh\frac{\beta}{4} \text{ dla } n \text{ parzystych} \qquad g_{n+1} = 1 \text{ dla } n \text{ nieparzystych}$ Znajomość parametrów  $g_{n}$  pozwala określić rzeczywiste wartości odpowiadających im reaktancji.

Transformacja częstotliwościDla filtrów dolnoprzepustowych  $\omega' = \frac{\omega}{\omega_G}$  gdzie  $\omega_G$  jest górną częstotliwością graniczną.Dla filtrów górnoprzepustowych  $\omega' = \frac{\omega_D}{\omega}$  gdzie  $\omega_D$  jest górną częstotliwością graniczną.Dla filtrów środkowoprzepustowych  $\omega' = \frac{\omega_0}{\omega_D - \omega_G} \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$ Szerokość pasma wynosi  $\Delta \omega_0 = \sqrt{\omega_D \omega_G}$ Dla filtrów środkowozaporowych:  $\omega' = \frac{\omega_D - \omega_G}{\omega_0 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$ Szerokość pasma wynosi  $\Delta \omega_0 = \sqrt{\omega_D \omega_G}$ Skalowanie wartości elementów realizuje się poprzez  $R_0 = R/r$  krotną zmianę wartości parametrów obliczonych,  $r = g_0$ , R jest rzeczywistą impedancją generatora.

			transformacja elementów	wartości reaktancji rzeczywistych	
		EDP		$L_{\lambda} = R_{\phi} \frac{g_{\lambda}}{\omega_{g}}$	
Transformacja częstotliwości i skalowanie impedancji	wego	rDP	s. ⊨ → c, ⊨	$C_{\lambda} = \frac{g_{\lambda}}{R_{g}\omega_{g}}$	
	rototype	FGP		$C_{\lambda} = \frac{1}{R_0 \omega_D g_{\lambda}}$	
	sgo filtru pi			$L_{z} = \frac{R_{0}}{\omega_{D}g_{z}}$	
	Inoprzepustowe	FPP	$-\stackrel{\circ}{\longrightarrow} -\stackrel{\sim}{\longrightarrow} \stackrel{\circ}{\longleftarrow} \stackrel{\circ}{\longrightarrow} \stackrel{\circ}{\longleftarrow} \stackrel{\circ}{\longrightarrow} \stackrel{\circ}{\rightarrow} $	$L_{zt} = R_0 \frac{g_t}{\omega_0 - \omega_D}$ $C_{zt} = \frac{\omega_0 - \omega_D}{R_0 \omega_0^2 g_t}$	
	sformacji Do			$C_{st} = \frac{g_t}{R_0(\omega_0 - \omega_D)}$ $L_{st} = R_0 \frac{\omega_0 - \omega_D}{\omega_0^2 g_t}$	
	odzaje trans	rodzaje tran			$C_{re} = \frac{1}{R_0 (\omega_0 - \omega_D) g_e}$ $L_{re} = R_0 \frac{g_e (\omega_0 - \omega_D)}{\omega_e^2}$
		FPZ	$\varepsilon = $	$C_{xt} = \frac{g_x (\omega_g - \omega_D)}{R_g \omega_c^2}$ $L_{xt} = \frac{R_g}{g_x (\omega_g - \omega_D)}$	





















Rezonator wnękowy  
stała fazowa 
$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda_c} = \sqrt{\left(\frac{\omega}{\nu}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$
Współczynnik odbicia na wejściu do falowodu  

$$\Gamma_{we} = S_{11} + \frac{S_{21}^2 \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L}$$
Jeśli ścianki zamykające falowód są metalowe to można przyjąć  

$$\Gamma_{we} = \Gamma_L = -1$$
stąd  

$$-1 = S_{11} - \frac{S_{21}^2}{1 + S_{22}}$$























































![](_page_28_Figure_2.jpeg)

![](_page_29_Figure_1.jpeg)

![](_page_29_Figure_2.jpeg)

![](_page_30_Figure_1.jpeg)

![](_page_30_Figure_2.jpeg)

![](_page_31_Figure_1.jpeg)

![](_page_31_Figure_2.jpeg)

![](_page_32_Figure_1.jpeg)

![](_page_32_Figure_2.jpeg)

![](_page_33_Figure_1.jpeg)

![](_page_33_Figure_2.jpeg)

![](_page_34_Figure_1.jpeg)

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

![](_page_35_Figure_1.jpeg)

SMA Plus		SMA Buildhead Jack	Type "N" Plug	SMA Four Hole Flange Mount	MCX Right Angle	
Złącza mikrofalowe		Impedance	50 Ohm	112		
		Frequency range	DC to 40 G	DC to 40 GHz		
		Dielectric withstanding volta	ge 500 Vrms a 125 Vrms a	500 Vrms at sea level 125 Vrms at 70,000 ft		
		Insulation resistance (min)	5,000 meg	5,000 megaohms		
	Electrical	Contact resistance (max)	Center con Outer cond	Center conductor 6.0 milliohms Outer conductor 2.0 milliohms		
	Data	Insertion loss (dB max)	0.1* / 1(0	0.1 * JT (GHz)		
		RF leakage	-80 dB at 3 -65 dB at 3	-80 dB at 3 GHz -65 dB at 3 to 26.5 GHz		
		VSWR (DC to 23 GHz)	1.10 :1 typ	cal (* Performance lis	ted is typical for the	
		VSWR (23 to 26.5 GHz)	1.15:1 typi	cal Gigalane SMP so	cket-to-socket bullet ADP-PFS-01	
		VSWR (26.5 to 40 GHz)	1.25 :1 typ	cal Performance on c	Performance on other configurations	
10 10 M		Radial misalignment	+/- 0.25 mr	+/- 0.25 mm		
	Mechanical Data	Axial misalignment	0 ~ 0.25 m	0 ~ 0.25 mm		
		Center to center spacing (min	1) 4.32 mm	4.32 mm		
		Center contact & socket	Beryllium o	Beryllium copper (with Au plating under Ni plating)		
	Material Data	Insulator	PTFE	PTFE		
		Shroud & body	Stainless S	Stainless Steel		
		Temperature range	-65 ~ +125	-65 ~ +125 °C		
	Environmental	Vibration	MIL-STD-2	MIL-STD-202 method 204, test condition D		
	Testing	Shock	MIL-STD-2	MIL-STD-202 method 223, test condition I		
		Thermal shock	MIL-STD-2	MIL-STD-202 method 107, test condition B		
			Full Detent	Limited Detent	Smooth Bore	
	Mechanical	Force to engage (max)	6.8 kg	4.5 kg	0.9 kg	
	Force	Force to disengage (min)	2.3 kg	0.9 kg	0.2 kg	
	ior Shrouds	Durability cycle (min)	100	500	1 000	

![](_page_36_Figure_1.jpeg)

![](_page_36_Figure_2.jpeg)

![](_page_37_Figure_1.jpeg)

![](_page_37_Picture_2.jpeg)

![](_page_38_Figure_1.jpeg)

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

![](_page_39_Figure_1.jpeg)

![](_page_39_Figure_2.jpeg)

![](_page_40_Figure_1.jpeg)

![](_page_40_Figure_2.jpeg)

![](_page_41_Figure_1.jpeg)

![](_page_41_Figure_2.jpeg)

![](_page_42_Figure_1.jpeg)

![](_page_42_Figure_2.jpeg)

![](_page_43_Figure_1.jpeg)

![](_page_43_Figure_2.jpeg)

Empiryczne parametry układu zastępczego można zapisać w postaci zależności :

 $\frac{Y'_0}{Y_0} = 1 - 0,67 \frac{h}{\lambda} \qquad \text{dla LiNbO}_3(YZ),$  $\frac{Y'_0}{Y_0} = 1 - 0,54 \frac{h}{\lambda} \qquad \text{dla SiO}_2(ST, X)$  $\frac{B}{Y_0} = -42 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \qquad \text{dla LiNbO}_3(YZ),$  $\frac{B}{Y_0} = -35 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 \qquad \text{dla SiO}_2(ST, X)$ 

Zależności te obowiązują dla 0,01 <  $h/\lambda$  < 0,03 oraz periodu  $\lambda/2$ 

Dla dostatecznie długich struktur odbijających można przyjąć, że podobnie jak w przypadku nieskończonego układu elektrod, w obszarze struktury propagują się fale postępujące i wsteczne, poza obszarem struktury propagują się zaś fale padające i odbite. Biorąc pod uwagę amplitudy tych fal oraz nakładając warunek zachowania energii sumy fal propagujących się w poszczególnych kierunkach otrzymuje się współczynnik odbicia dla całej struktury odbijającej.

89

![](_page_44_Figure_5.jpeg)

![](_page_45_Figure_1.jpeg)

![](_page_45_Figure_2.jpeg)

![](_page_46_Figure_1.jpeg)

![](_page_46_Figure_2.jpeg)

47

![](_page_47_Figure_1.jpeg)

![](_page_47_Figure_2.jpeg)

![](_page_48_Figure_1.jpeg)

![](_page_48_Figure_2.jpeg)

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

![](_page_49_Figure_2.jpeg)

![](_page_50_Figure_1.jpeg)

![](_page_50_Picture_2.jpeg)

![](_page_51_Figure_1.jpeg)

![](_page_51_Figure_2.jpeg)